國立交通大學

電機學院微電子奈米科技產業研發碩士班

碩士論文

新穎快閃記憶體結構使用HfO2為電荷捕陷層於SiGe與Si通道之研究

Study on Novel Structures for Flash Memory using
HfO₂ as Charge Trapping Layer with SiGe and Si Channels

研 究 生:洪錦石

指導教授:雷添福 博士

中華民國九十六年一月